

Cesta De Limpeza De Wafer De Ptfе De Alta Pureza Portador De Wafer De Silício Resistente A Ácidos Suporte De Gravação Em Fluoropolímero

Número do item: PL-CP284



introdução

Garanta processamento de semicondutores livre de contaminação com nossas cestas de limpeza de wafer de PTFE de alta pureza. Projetadas para gravação e limpeza agressivas, esses portadores personalizáveis oferecem resistência química excepcional e estabilidade térmica para o manuseio de wafers de silício durante processos críticos de fabricação química úmida.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Principal Benefício
Limpeza Padrão RCA	Etapas sequenciais de limpeza SC-1 e SC-2 para remover resíduos orgânicos e contaminantes metálicos de wafers de silício.	Evita a lixiviação de íons metálicos, garantindo ambientes de processamento ultra puros.
Gravação Piranha	Uso de misturas de ácido sulfúrico e peróxido de hidrogênio para remover materiais orgânicos pesados e fotorresiste.	Resiste a reações exotérmicas extremas e oxidação agressiva sem degradação.
Imersão/Gravação com HF	Remoção de camadas de óxido sacrificial ou óxidos nativos usando soluções de ácido fluorídrico.	Imunidade completa ao ataque de HF, que destruiria portadores de vidro ou quartzo.
Texturização de Células Solares	Imersão de wafers de silício em soluções alcalinas ou ácidas para criar texturas de superfície de captura de luz.	Alto rendimento de volume e resistência a soluções concentradas de KOH ou NaOH.
Limpeza Pós-CMP	Remoção de partículas de pasta de polimento e resíduos químicos após o Polimento Mecânico-Químico.	Superfície antiaderente evita a redeposição de pasta no portador e nos wafers.
Fotolitografia	Etapas de revelação e remoção envolvendo solventes orgânicos agressivos e reveladores.	Construção resistente a solventes garante nenhum inchaço ou amolecimento do material do portador.
Limpeza Ultrasônica	Limpeza acústica de alta frequência de componentes eletrônicos delicados em soluções aquosas.	Transmite energia ultrassônica de forma eficaz, protegendo os componentes contra impacto mecânico.
Processamento de GaAs	Gravação química úmida e limpeza de substratos de semicondutores compostos para optoeletrônica.	Suporte suave e seguro para substratos quebradiços durante etapas críticas de fabricação.

Parâmetro	Descrição / Especificação (Série PL-CP284)
Número do Item do Produto	PL-CP284
Material Principal	PTFE Virgem de Alta Pureza (Politetrafluoroetileno)
Compatibilidade Química	Universal (Ácidos Fortes, Bases, Solventes, Oxidantes)
Tamanhos Padrão de Wafer	Compatível com wafers de 4 polegadas, 6 polegadas e 8 polegadas
Opções de Personalização	Dimensões, quantidades e larguras de ranhuras totalmente personalizáveis

Aplicação	Descrição	Principal Benefício
Parâmetro	Descrição / Especificação (Série PL-CP284)	
Configurações de Alça	Estilos fixo, removível ou compatível com robótica (Personalizável)	
Temperatura de Operação	-200°C a +260°C (Contínua)	
Acabamento de Superfície	Superfície usinada por CNC de alta precisão, baixa porosidade	
Design de Ranhuras	Forma de V ou perfis personalizados para área de contato mínima	
Processo de Fabricação	100% Usinado por CNC para precisão e integridade estrutural	
Nível de Pureza	Grau de análise de traços, fabricação sem metais	